

SOD-323 Schottky Barrier Diode 肖特基势垒二极管

Internal Configuration & Device Marking 内部结构与产品打标

Type 型号	RB501V-40
Pin 管脚	 
Mark 打标	4

Absolute Maximum Ratings 最大额定值

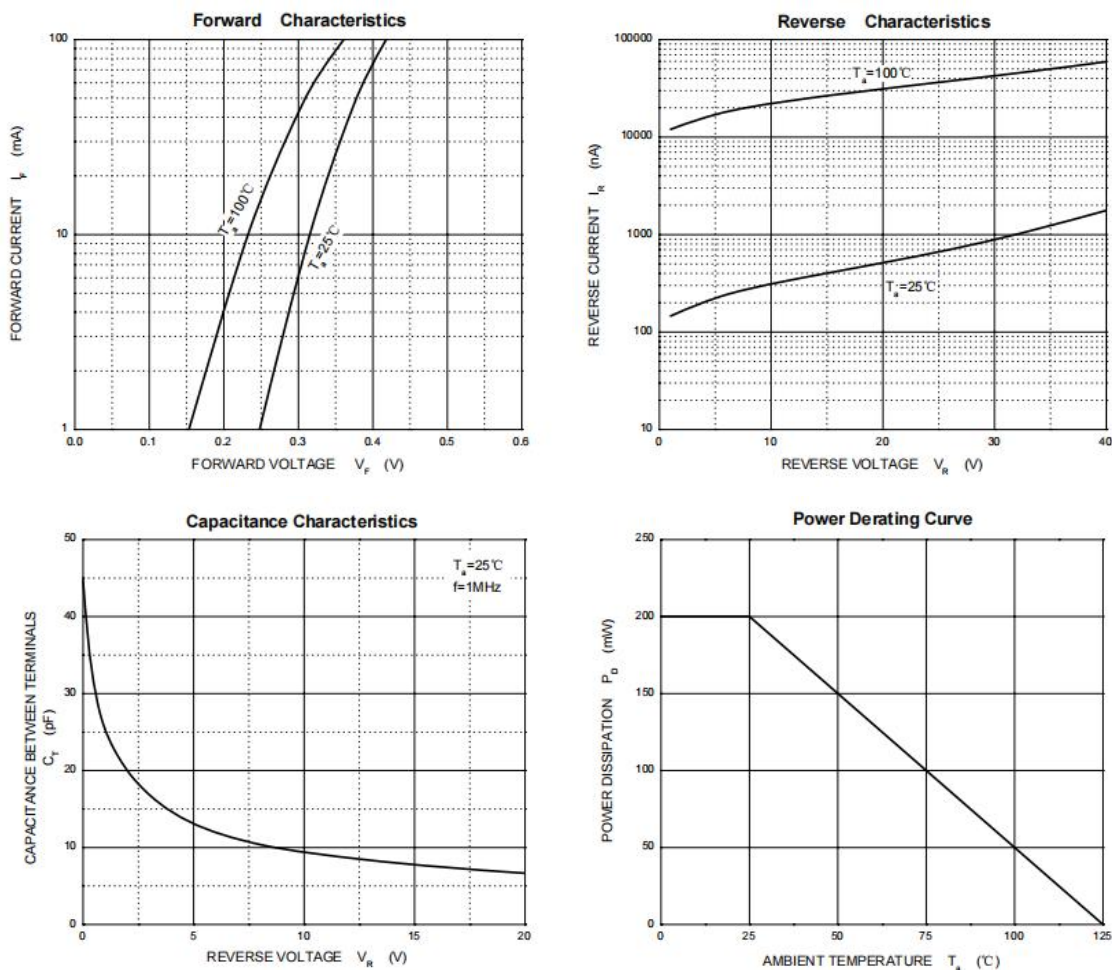
Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Rat 额定值	Unit 单位
Peak Reverse Voltage 反向峰值电压	V_{RM}	45	V
DC Reverse Voltage 直流反向电压	V_R	40	V
Forward Work Current 正向工作电流	$I_F(I_O)$	100	mA
Peak Surge Forward Current 正向峰值浪涌电流 @t=8.3ms	I_{FSM}	1	A
Power dissipation 耗散功率	$P_D(T_a=25^{\circ}C)$	200	mW
Thermal Resistance J-A 结到环境热阻	$R_{\theta JA}$	500	$^{\circ}C/W$
Junction and Storage Temperature 结温和储藏温度	T_J, T_{stg}	-55to+125 $^{\circ}C$	

Electrical Characteristics 电特性

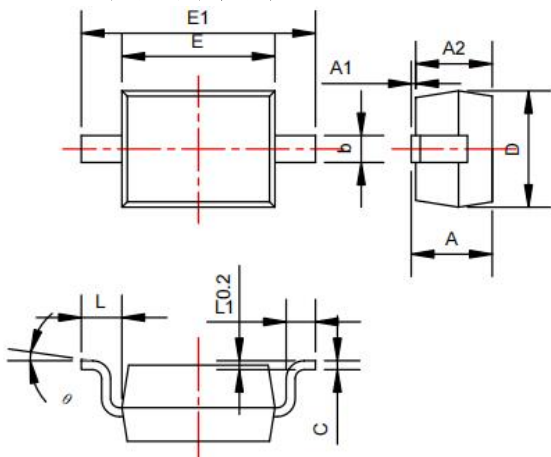
($T_A=25^{\circ}C$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25 $^{\circ}C$)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压($I_R=10\mu A$)	$V_{(BR)}$	40	—	—	V
Reverse Leakage Current 反向漏电流($V_R=10V$)	I_R	—	—	30	μA
Forward Voltage($I_F=100mA$) 正向电压($I_F=10mA$)	V_F	—	—	0.55 0.34	V
Diode Capacitance 二极管电容($V_R=10V, f=1MHz$)	C_D	—	6	—	pF

■ Typical Characteristic Curve 典型特性曲线



■ Dimension 外形封装尺寸



SYMBOL	DIMENSIONS	
	MIN.	MAX.
A		1.000
A1	0.000	0.100
A2	0.800	0.900
b	0.250	0.350
c	0.080	0.150
D	1.200	1.400
E	1.600	1.800
E1	2.500	2.700
L	0.475REF	
L1	0.250	0.400
θ	0 $^\circ$	8 $^\circ$